

PH231 Classical Electromagnetism I

Final Helpdesk

Dyne Kim

June 05, 2024

연사 소개

이름: 김다인 ($1 \text{ dyn} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm}/\text{s}^2$)

수리과학과 석박사통합과정 1년차 (학번 20248020)

B. Sc. in Mathematics and Physics (KAIST, 학사 21학번)

서울과학고 30기

2020 IPhO 한국 국가대표 최종후보

2021년 전자기학I 수강, A+ 학점 획득:

궁금한 것이 있다면 +82 10 8210 8772 또는 physics0907@kaist.ac.kr로
연락해 주세요.

정전기 에너지

시험전하 q 가 \mathbf{a} 에서 \mathbf{b} 로 이동한 경우 전기력이 한 일은 다음과 같다:

$$\int \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \, dt = \int q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \, dt = \int_a^b q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -qV(\mathbf{b}) + qV(\mathbf{a})$$

따라서 고정된 전위 내에서 시험전하의 에너지는 qV 이다.

반면에 시험전하가 아닌 전하분포 전체의 에너지를 구하고자 할 경우 자신이 만드는 퍼텐셜은 자신에게 일하지 않으므로 두 번 세어지는 일을 막기 위해 계수 $1/2$ 이 필요하다. 이는 부분적분하면 다음과 같아진다:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \rho V \, d^3\tau = -\frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathbb{R}^3} V \nabla^2 V \, d^3\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla V|^2 \, d^3\tau = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{E}|^2 \, d^3\tau \end{aligned}$$

그러므로 $\frac{\varepsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2$ 를 **에너지 밀도(energy density)**로 간주할 수 있다. 에너지가 전하에 있는지, 장에 있는지는 관점의 차이로, 두 공식 모두 실제로 보존되는 퍼텐셜 에너지를 제공한다.

점전하의 형성에너지

점전하가 생성하는 전기장은 r^{-2} 에 비례하므로, 이를 제곱하여 적분하면 ∞ 가 나온다. 그러므로 점전하의 형성에너지를 위 공식으로 구할 수 없다. 이러한 모순은 고전 전자기학의 문제점 중 한 가지이다. 이에 대한 대안으로 (i) 점전하는 이미 형성되어 있으므로 그 형성 과정에서 드는 에너지를 논할 수 없다, (ii) 사실 점전하는 존재하지 않으며, 소립자들은 끈 (e.g. 초끈 이론) 등 다른 형태이다, 등이 존재한다. 또한 정전기 에너지는 전하에 대하여 선형이 아니다 - 따라서 전하분포를 분할하여 각각의 에너지를 구한 후 합할 수 없다.

선형 매질에서의 정전기 에너지

우리가 통제할 수 있는 자유전하의 에너지만을 계산하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \rho_f V \, d^3\tau = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} V \nabla \cdot \mathbf{D} \, d^3\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d^3\tau = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \varepsilon |\mathbf{E}|^2 \, d^3\tau \end{aligned}$$

매질에 이력(hysteresis) 등 비선형성이 있는 경우에는 매질 내에서 정전기 에너지가 열에너지로 전환되며 손실이 발생할 수 있다.

퍼텐셜계수

연결 도체 영역 U_1, \dots, U_n 과 그 밖의 자유 영역을 고려하자. 고정된 i 에 대하여 U_i 의 전위가 V 이며 나머지 도체들이 접지되었을 경우 도체 U_j 에 유도된 전하량 Q_j 는 V 에 비례한다 - 이 비례계수를 C_{ji} 라 한다. 그러므로 각각의 i 에 대하여 U_i 에 대전된 전하량을 Q_i , U_j 의 전위를 V_j 라 하면 다음이 성립한다:

$$Q_i = \sum_{j=1}^n C_{ij} V_j, \quad V_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} Q_i$$

여기에서 $(C_{ij})_{i,j}$ 의 역행렬을 $(P_{ij})_{i,j}$ 라 한다. 에너지는 다음과 같다.

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n P_{ij} Q_i Q_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} V_i V_j$$

퍼텐셜계수

U_i 에 전하 Q , 다른 곳에 전하 εQ ($\varepsilon \ll 1$)가 대전된 경우의 에너지는 두 가지 방식으로 구할 수 있다. 따라서 $P_{ij} = P_{ji}$ 이다.

$$U = \frac{1}{2}P_{ii}Q^2 + \sum_{i \neq j} \frac{\varepsilon}{2}(P_{ij} + P_{ji})Q^2 + O(\varepsilon^2) = \frac{1}{2}P_{ii}Q^2 + \sum_{i \neq j} P_{ij}\varepsilon Q^2 + O(\varepsilon^2)$$

퍼텐셜계수

$i \neq j$ 를 고정하자. U_i 에 Q , U_j 에 xQ ($x \in \mathbb{R}$)이 분포하는 경우 에너지는,

$$P_{jj}Q^2x^2 + 2P_{ij}Q^2x + P_{ii}Q^2 \geq 0$$

따라서 판별식 $4(P_{ij}^2 - P_{ii}P_{jj}) \leq 0$ 이며 $P_{ij} \leq \sqrt{P_{ii}P_{jj}}$ 이다. U_i 와 U_j 를 도체선으로 연결하고, 둘에 대전된 전하량이 Q, Q' 이라 하자.

$P_{ii}Q + P_{ij}Q' = P_{jj}Q' + P_{ij}Q$ 이므로 $Q' = \frac{P_{ii}-P_{ij}}{P_{jj}-P_{ij}}Q$ 이다. $P_{ii} < P_{ij}$ 라

가정하자. 그 경우 위 논의에 의해 $P_{jj} > P_{ij}$ 이다. 이는 두 도체 중 하나에는 양전하가, 다른 것에는 음전하가 분포함을 의미한다. 일반성을 잃지 않고 도체의 퍼텐셜이 양수라 하자. 면전하의 경계조건에 의해 음전하가 있는 쪽 도체에 가까운 도체 바깥 지점에서 퍼텐셜이 더 크다. 이는 Laplace 방정식의 해가 영역 내부에서 최댓값을 가지지 않음에 모순이다. 따라서 모든 i, j 에 대하여 $P_{ij} \leq P_{ii}$ 이다.

축전기

도체 U_1, U_2 에 각각 전하 $+Q, -Q$ 가 분포한다 하자. 그 경우 두 도체 사이의 전위차는 다음과 같다.

$$\Delta V = (P_{11} + P_{22} - 2P_{12})Q$$

이 비례계수의 역수를 **전기용량(capacitance)** C 라 한다.

$$Q = C\Delta V, \quad \Delta U = \frac{1}{2}C\Delta V^2$$

예를 들어, 유전율 ε 의 매질로 채워진 면적 A , 거리 d 의 평행판 축전기의 경우 $C = \varepsilon A/d$ 이다. 전기용량은 직렬연결 시 $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$ 이며 병렬연결 시 $C = C_1 + C_2$ 이다. (저항과 식이 반대!)

에너지에 의한 힘과 토크의 계산

고립된 (Q 가 고정된) 계를 생각하자. 에너지 U 가 대상 물체의 좌표 x_i 의 함수로 주어진 경우, 해당 물체는 $F_i = -\frac{\partial U}{\partial x_i}$ 의 힘을 x_i 방향으로 받는다. 마찬가지로 각도좌표 θ_i 의 함수인 경우 $\tau_i = -\frac{\partial U}{\partial \theta_i}$ 의 토크를 받는다. 반대로 외부에서 전하를 공급하여 전위차 V 를 일정하게 유지하고 있는 계를 생각하자. 이 경우에는 외부에서 공급하는 에너지도 계산에 포함시켜야 한다:

$$E = \frac{1}{2} \int \rho V d^3\tau - \int \rho V d^3\tau$$

그러므로 위 경우와 비교해 힘과 토크의 크기는 같고 방향이 반대이다.

전류밀도

다양한 종류의 전하 운반자들이 움직이는 경우를 생각하자. i 번째 종류의 전하 운반자에 의한 전하밀도를 $\rho_i(\mathbf{x})$, 속도장을 $\mathbf{v}_i(\mathbf{x})$ 라 하자. 그 경우 **전류밀도(current density)**를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sum_i \rho_i(\mathbf{x}) \mathbf{v}_i(\mathbf{x})$$

어떠한 곡면 S 에 대하여 전류밀도를 면적분한 값을 해당 곡면을 통과하는 **전류(current)**라 한다.

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

전하의 경우와 마찬가지로, \mathbf{J} 가 곡선/곡면에 지지되는 δ 함수 형태인 경우 **선전류**와 **면전류**를 얻는다.

국소적 전하량 보존

국소적 전하량 보존은 다음의 연속방정식에 의해 표현된다.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

이는 Maxwell 방정식으로부터 유도될 수 있다:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) = \epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \epsilon_0 c^2 \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{J}) = -\nabla \cdot \mathbf{J}$$

상대론적 4-벡터 표현으로는 다음과 같다.

$$J^\alpha = (c\rho, \mathbf{J}), \quad \partial_\alpha = (c^{-1}\partial_t, \nabla), \quad \partial_\alpha J^\alpha = 0$$

Ohm의 법칙

도체에 전기장이 가해지면 전기장에 비례하는 전류밀도가 발생한다. 그 비례상수를 **전기전도도** σ , 역수를 **비저항** ρ 라 한다.

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = \rho \mathbf{J}$$

단면적 A , 길이 L , 비저항 ρ 의 물질에 전류밀도 \mathbf{J} 가 균일하게 길이에 평행한 방향 \mathbf{n} 으로 흐를 경우 양단의 전위차는 다음과 같다.

$$\Delta V = \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}L = \rho \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}L = \rho \frac{L}{A} I = IR$$

그러므로 저항값은 $R = \rho L/A$ 이다.

정전류와 Kirchoff 법칙

[fragile] 전류 및 전하 분포가 정적(시간에 따라 불변)이라 하자. 그 경우,

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

전기전도도가 σ 로 일정한 도체 내에서 다음이 성립한다.

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \nabla \cdot \mathbf{E} = \sigma \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

전기전도도가 변화하는 경계면에서 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{J}_2 \cdot \mathbf{n} &\Rightarrow \sigma_1 \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{n} = \sigma_2 \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{n} \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 &\Rightarrow (\mathbf{E}_1)_{||} = (\mathbf{E}_2)_{||} \end{aligned}$$

$\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 과 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 을 폐곡선/폐곡면에서 적분하면 다음을 얻는다.

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \Delta V_C = 0 \quad , \quad \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I_S = 0$$

정자기학의 기본법칙

Lorentz 힘 법칙:

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Ampere 법칙:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad , \quad \oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot \mathbf{T} \, dl = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS = I_S$$

자기 Gauss 법칙:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad , \quad \Phi_{\mathbf{B}}(\partial V) = \oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, dS = 0$$

Biot-Savart 법칙:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, d\tau'$$

벡터 퍼텐셜

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 이므로 어떠한 (유일하지 않은) \mathbf{A} 에 대하여 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 로 표현 가능하다. $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 인 것을 선택하면 (쿨롱 게이지),

$$\mu_0 \mathbf{J} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau'$$

이는 원천이 ρ 대신 \mathbf{J} 임을 제외하면 스칼라 퍼텐셜과 동일한 형태이다:

$$A_i(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}|^{l+1}} \int_{\mathbb{R}^3} J_i(\mathbf{r}') |\mathbf{r}'|^l P_l(\cos \theta) d\tau' \quad (|\mathbf{r}'| > |\mathbf{r}|)$$

따라서 **쌍극자 모멘트** \mathbf{m} 을 정의한다:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') d\tau', \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} + O(r^{-3})$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}}{r^3} \right]$$

매질 내의 자기 쌍극자

매질 \mathcal{V}_0 내에 단위부피당 자기 쌍극자 밀도 \mathbf{M} 이 존재한다 하자. 이는 다음의 벡터 퍼텐셜을 생성한다.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}_0} \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\tau' \\&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}_0} \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \\&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}_0} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\tau' - \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}_0} \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) d\tau' \\&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}_0} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\tau' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\partial\mathcal{V}_0} \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \mathbf{n}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS'\end{aligned}$$

따라서 이는 매질 내에서 $\mathbf{J}_b(\mathbf{r}') = \nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')$, 표면에서 $\mathbf{K}_b(\mathbf{r}') = \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \mathbf{n}$ 의 속박전류가 생성하는 벡터 퍼텐셜과 동일하다.

자유전류와 **H**장

우리가 통제할 수 없는 속박전류를 제외한 자유전류 $\mathbf{J}_f = \mathbf{J} - \mathbf{J}_b$ 를 고려하자. 그 경우, 다음과 같이 정의된 장

$$\mathbf{H} := \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$$

는 다음을 만족시킨다:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J} - \mathbf{J}_b = \mathbf{J}_f$$

\mathbf{M} 이 외부 자기장 \mathbf{B} 에 비례하는 경우, 자기감수율 χ_m 과 투자율 μ :

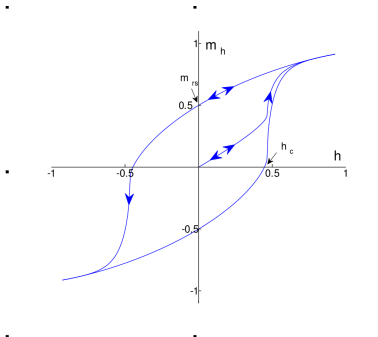
$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\chi_m} \mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0(1 + \chi_m)} \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$$

자성체의 분류

반자성체: 감수율 $\chi_m \sim -10^{-5}$.

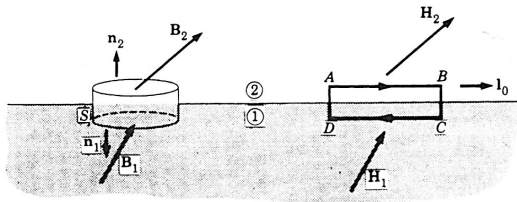
상자성체: 감수율 $\chi_m \sim 10^{-5}$.

강자성체: 선형 영역에서는 감수율 큰 양수. 자기이력(hysteresis) 발생.
자기장을 없앴 후에도 반영구적인 쌍극자 모멘트가 잔존하므로
영구자석을 만들 수 있다.



정자기학의 경계조건

$$(\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) \cdot \mathbf{n}_2 = 0 \quad , \quad \mathbf{n}_2 \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$



선형 매질의 경우,

$$\mathbf{n}_2 \times (\mu_2^{-1} \mathbf{B}_2 - \mu_1^{-1} \mathbf{B}_1) = \mathbf{K}$$

또한, 선형 매질 내에서 \mathbf{J}_f 는 다음을 만족시킨다.

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}_f$$

예시: 균등하게 자화된 구

상수 $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$ 를 가지는 반경 a 의 구를 고려하자. 자유전류가 없으므로 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ 이며, 따라서 $\mathbf{H} = -\nabla\phi_M$ 으로 표현 가능하다.

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla^2\phi_M = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{B} - \nabla \cdot \mathbf{M}$$

그러므로 이는 (ϵ_0 를 제외하면) $-\nabla \cdot \mathbf{M}$ 의 전하분포에 의해 생성된 전기퍼텐셜과 동일한 방식으로 계산할 수 있다:

$$\phi_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{3}Ma^2 \frac{r_{\leq}}{r_{\geq}^2} \cos\theta$$

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = -\frac{1}{3}\mathbf{M}, \quad \mathbf{B}_{\text{in}} = \mu_0(\mathbf{H}_{\text{in}} + \mathbf{M}) = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$$

$$\mathbf{H}_{\text{out}} = \frac{r^2}{a^3}(M \cos\theta \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{3}M\hat{\mathbf{z}}) = \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}}{4\pi r^2}$$

예시: 균등하게 자화된 구

Biot-Savart 법칙에 의해 \mathbf{A} 를 계산할 수도 있다.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 M}{4\pi} \oint_S \frac{\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{n}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \\ &= \frac{\mu_0 M a^2}{4\pi} \hat{\phi} \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \phi'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \\ &= \frac{\mu_0 M a^2}{3} \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \sin \theta\end{aligned}$$

이를 미분하면 위와 같은 \mathbf{B} 장을 얻을 수 있다.

Faraday 법칙과 Lenz 법칙

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

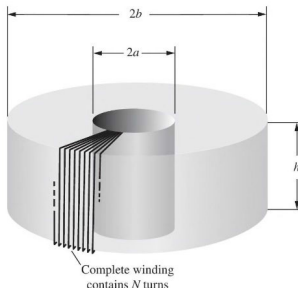
시간-의존하는 곡면 $S(t)$ 를 고려하자. $\Phi(t)$ 가 시간 t 에서 $S(t)$ 를 통과하는 자기선속이라 하자. 그 경우,

$$\begin{aligned}\frac{d\Phi}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left(\int_{S(t+\Delta t)} \mathbf{B}(t+\Delta t) \cdot \mathbf{n} \, dS - \int_{S(t)} \mathbf{B}(t) \cdot \mathbf{n} \, dS \right) \\ &= \int_{\partial S} \mathbf{B} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{T}) \, dl + \int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= \int_{\partial S} -(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{T} - \mathbf{E} \cdot \mathbf{T} \, dl = -\mathcal{E}\end{aligned}$$

유도계수

코일에 전류가 흐를 경우, 해당 코일을 통과하는 자기선속 Φ_B 는 전류 I 에 비례한다. 비례계수를 **자기유도계수**(인덕턴스) L 이라 한다: $\Phi_B = LI$.

예를 들어 내반경 a , 외반경 b , 높이 h 의 원판에 N 회 감긴 코일의 경우,



Ampere 법칙의 적분형에서 대칭성을 사용하면, 축에서 r 떨어진 곳에서,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \hat{\phi} \quad , \quad \Phi_B = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \log(b/a) \quad , \quad L = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \log(b/a)$$

유도계수

마찬가지로, 전류가 흐르는 코일이 *다른 코일에* 생성하는 자기선속을 고려할 수도 있다. 이 경우의 비례계수를 **상호유도계수** M_{ij} 라 한다.

$$\Phi_j = \sum_i M_{ij} I_i$$

이는 다음 공식을 통해 계산할 수 있다 (특히 $M_{ij} = M_{ji}$ 이다):

$$\Phi_1 = \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_{\partial S_1} \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}_1 \, dl_1 = I_2 \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\partial S_1} \oint_{\partial S_2} \frac{\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \, dl_1 \, dl_2$$

이를 통해 자기 에너지를 계산할 수 있다.

$$E = \sum_i \frac{1}{2} L_i I_i^2 + \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} M_{ij} I_i I_j$$

정전기 에너지와 마찬가지로, 이를 통해 힘과 토크를 구할 수 있다.

자기 에너지 밀도

그러므로 코일들로 구성된 계에서,

$$dW = I \delta \Phi_B = \frac{1}{2} I \int \delta \mathbf{A} \cdot \mathbf{T} dl = \int (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \delta \mathbf{A} d\tau = \int \mathbf{H} \cdot \delta \mathbf{B} d\tau$$

따라서 선형 매질의 경우,

$$E = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{2\mu} |\mathbf{B}|^2$$

자기이력이 발생하는 경우 매질 내에서 에너지가 소모된다.

Ampere-Maxwell 법칙

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \mathbf{J}_E) = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

여기에서 $\mathbf{J}_E = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ 를 **변위전류(displacement current)**라 한다.
 $\nabla \cdot (\mathbf{J} + \mathbf{J}_E) = 0$ 이다. 매질이 있는 경우, 전기 쌍극자 \mathbf{P} 가 시간에 따라 변한다면 다음의 쌍극자 변위전류가 발생한다.

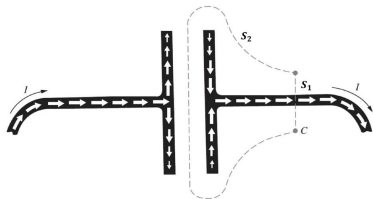
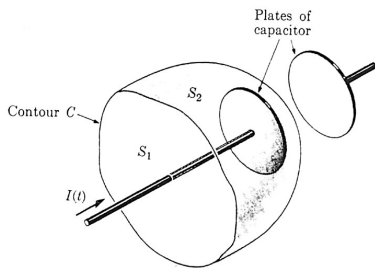
$$\mathbf{J}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}, \quad \frac{\partial \rho_b}{\partial t} = \frac{\partial(-\nabla \cdot \mathbf{P})}{\partial t} = -\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_P$$

따라서 $\mathbf{J}_D = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 라 하면,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_D = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot (\mathbf{J}_f + \mathbf{J}_D) = 0$$

예시: 평행판 축전기

평행판 축전기가 충전될 경우 변위전류가 발생하며, 이것이 다시 자기장의 원천으로 작용한다:



Poynting 정리

전자기력이 하는 단위부피당 일은 다음과 같다:

$$\begin{aligned}\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} &= (\rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \\&= \mathbf{E} \cdot \left(\mu_0^{-1} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\&= \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{E}) + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} \right) \\&= -\nabla \cdot (\mu_0^{-1} \mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \right)\end{aligned}$$

따라서 일반적인 경우에 $\frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}$ 가 전자기 에너지 밀도이며, Poynting 벡터 $\mathbf{S} = \mu_0^{-1} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 가 에너지 수송 밀도이다.

일 대신 힘 \mathbf{f} 에 대하여 유사한 계산을 수행하면 $\mathbf{f} = -\nabla \cdot \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{T}} - \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t}$ 를 얻는다. 따라서 \mathbf{S} 는 운동량 밀도이며 **Maxwell 변형력 텐서**라 불리는 $\overset{\leftrightarrow}{\mathbf{T}}$ 가 운동량 수송 밀도이다. (운동량의 방향과 운동량이 수송되는 방향이라는 2가지 방향 정보를 가지므로 이는 텐서이다.)